





Stéphane Guillerez CEA –INES RDI 50 avenue du lac léman 73370 Le Bourget du Lac E-mail: stephane.guillerez@cea.fr









Conversion photovoltaïque dans les cellules organiques

Principe de base: Hétérojonction entre deux matériaux semiconducteurs







Propriétés électroniques des semiconducteurs







(e)





Mobilité des porteurs

2: structure en réseaux interpénétrés



Substrat transparent TCO Semiconducteur donneur -type p Semiconducteur accepteur -type n

Cathode réfléchissante

Epaisseur couche active limitée par •Mobilité des porteurs









Structures de couches actives

Interface donneur accepteur >> surface géométrique de la cellule

Contrôle des paramètres de dépôt ----- Développement de l'interface



Séparation de phase spontanée entre matériaux





Dépot en solution Polymère/petite molécule

TEM images of P3HT/PCBM film morphology after thermal annealing: b) **150°C for 30 min; c) 150°C for 2h** From Ma et al., Adv. Funct. Mater., **2005**, *15*, 16717

Filière petites molécules : dépôt PVD Filière polymère : dépot en solution









Un peu d'histoire

•Tang (Kodak)

1^{ère} cellule organique à hétérojonction Cellule bicouche, molécules évaporées PCE = 0.95% @ 70 mW/cm² Brevet: 1979 – publi : 1986





•Cellules polymères

1992: 1^{ère} cellule bicouche polymère/ C60
Brevet Saricifti et Heeger 1992, publi 1993
1994: 1^{ère} Cellule à hétérojonction en volume mélange polymère/fullérène
1995: introduction PCBM















Evolution of performances



liten

DTS/LCP





Evolution des polymères



DTS/LCP

- 6eV

- 4.3 eV

LUMO

HOMO

Α

V_{BI}





Polymère	Structure	λ _{max} (nm)	λ _{offset} (nm)	Gap (eV)	LUMO (eV)	HOMO (eV)	PCE (%) *[70]PCBM	
HBG								
РЗНТ		515	650	1.9	3.2	5.1	4-5	
PCDTBT		515	650	1.9	3.6	5.5	4.6* 6.1* 7.13*	
PSiFDBT	·+C_BH17 C_BH17 PSIF-DBT	584	680	1.82	3.57	5.39	5.4	
PIC-DTBT	$\begin{array}{c} C_{ig}H_{21} \\ & \swarrow \\ & & \swarrow \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ $	398/540	630	1.9	3.55	5.45	1.47	
LBG								
PTB1		680	760	1.7	3.2	4.9	7.4*	0.6-2 0.7-00
PCPDTBT	·+S C ₀ H ₁₇ C ₀ H ₁₇ C ₀ H ₁₇ N S N	775	890	1.4	3.55	5.3	5.5*	0.9- 10-C
TP6	$\begin{array}{c} C_{ij}H_{2i}\sum_{k\in C}C_{ij}H_{2i} & C_{k}H_{k} \\ \cdot + & & & \\ \cdot + & & & \\ C_{ij}H_{2i}C_{ij}C_{ij}H_{2i} \\ \cdot + & & \\ C_{ij}H_{2i}C_{ij}C_{ij}H_{2i} \\ \end{array} $	430/640	725	1.7eV	3.59	5.32	1.27	od) 11 OW 1.11
pBBTDPP2	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} C_{1}H_{17} \\ \\ C_{12}H_{25} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C_{12}H_{25} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} O \\ \\ O \\ \\ O \\ \\ O \\ C_{1}H_{17} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C_{12}H_{25} \\ \\ O \\ O \\ \\ O \\ \\ O \\ \\ O \\ O \\ \\ O \\ \\ O \\ O \\ \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \\ O $	810	860	1.4	-	-	4*	1.3 3 2.5 Band gap of the donor / eV
P7	$\begin{array}{c} C_{i}H_{1\gamma}, C_{i}H_{1\gamma} \\ - \int_{S}^{S} + \int_{S}^$	700	1000	1.24	3.80	5.31	-	Scharber et al, Adv. Mater18, 789, (2006)
DTS/LCP								





Dispositifs

•Structure 'classique' (historique)



Simple: 3- 4 couches déposées Excellent rendement initial (4-5% pour P3HT:PCBM)

Difficile à industrialiser Stabilité de la cathode





Short lifetime due to cathode's degradation No printable electrode materials







•structure PIN

Common use in inorganic PV (suppress recombinations at metal contacts) Introduced in organic LED's (K. Leo, M. Pfeiffer and coll: 2002)

PV (K. Leo, M. Pfeiffer, S. Sariciftci and coll: 2004 on small molecules,

M. Glathaar et al : 2005 on polymers*)













DTS/LCP





Lifetime study Ageing of flexible solar cell under AM1.5 illumination. Encapsulation with Escal ® barrier films



•Loss of PCE driven by evolution of Jsc

•Filter effect of oxide layer (protection of active layer against UV light?)

PIN structure compatible with full printing on flexible substrates (low temperature process) Good stability demonstrated Basic structure for tandem cells: application of injection layers







•structures multi-jonctions







(low loss in current expected)

œ

energie atomique · energies atternatives





Connection en série des sous-cellules

Nécessité d'équilibrer les courants produits dans les sous-cellules (courant total limité par la plus faible cellule)









Cellules tandems 4 fils



Conclusion:

Cellules PIN = technologie de référence avec un potentiel de rendement de 8-10% en cellule, une DDV de 10.000 heures Progrès considérables depuis 2007 sur matériaux actifs

Technologie des cellules tandems adaptée à l'organique – développement à l'échelle labo









Technologies de production des cellules solaires organiques

Petites molécules



Technologies de dépôt sous vide

Polymères

Technologies de dépôt en voie humide

•Filière 'petites molécules'



> Société de référence : Heliatek (Dresden)

Participations de Bosch, RWE, BASF Coll IAPP, Fh IPMS Record mondial de perf à 8.3% (coll. avec IAPP)

Technologie de production au déroulé sur support flexible





Installation de dépôt sous vide en ligne à l'IPMS ; COMEDD II (remerciements: O. Hild)







Page d'accueil du site de Heliatek



Part of the solution to both the worlds energy and environmental issues

Affordable energy for emerging nations

Light-weight, flexible energy on the move









Installation de dépôt en ligne de l'IPMS (OLED's)











•Filière 'polymères'



Société de référence : Konarka (Lowell, MA)

4 sites : Lowell, New Bedford, Nuremberg, Linz >100 pers Participations de Total (45 M\$), Konica-Minolta (20 M\$), ...

Ligne pilote de 150 mm de large



Modules monolitiques auto-alignés
10 lignes connectées en série (150 mm de large)







Ligne de production

Ligne Polaroid de capacité 10 M.m²/an



Annonce Konarka 2008

Rdt de 10% module Production totale modules PV: 10.7 GW en 2009 Consommation de produits actifs: 2 T /an











Initiatives industrielles en France (incluant le CEA)

Production de modules OPV: technologie adaptée au marché











Projet OSCAR : Partenariat: **ARMOR**, CEA, LCPO, Alcan, Plasto, Budget total: 16 M€; financement OSEO Objectif: industrialiser technologie d'ici 4 ans **Coordination du projet** Développment de films **Conception/réalisation outil industriel** Commercialisation barrières transparents Partenaires pour Partenaires de l'intégration R&D pour les technologique et éléments du scale-up constitutifs de la h Packaging Cellule Nouveaux matériaux

DuPon CEA Teijing ARMOR INES **Electrode transparente** •Conception cellules et modules rkem Film Polymère semiconducteur LCPO Plast Développement procédés labo Bordeaux 0 Interface électronique Caractérisation modules Benchmark matériaux Fournisseur(s) Privilégié(s) Développment d'adhésifs Adhésivage du film barrière











Produits adaptés à la demande
Volumes limités (qqs 10³
Procédés d'impression numérique (Jet d'encre, spray, ...)
Capacité de prod modérée
Prix moyen
Coût du changement design faible

Procédé Jet d'encre

Principe de base du jet d'encre



Technologie numérique rapide



Presse jet d'encre Agfa 'the factory' (900m²/h en 63 cm de laize)









2 projets industriels de la conception à la réalisation de modules OPV « sur-mesure »











Development at lab-scale



Dimatix DMP 2800



ZnO + active layer + HIL on PET/ITO



Development at pilot-scale



4 printing heads, 512 nozzles XY position accuracy : < +/- 5 μ m Printing area: 300 x 300 mm Printing speed up to 2500 cm²/min (1 head) Operating under inert gas









Conclusion

Development of PIN architectures on flex

PCE= 3.5 % (max: 3.7) Extended lifetime: PCE = 2% after 6000 h

Ongoing Industrial projects on printing technologies

Inkjet: small markets, customized products R2R: large markets, standardized products

Development of barrier film by wet process

WTR = 2.10⁻³ g.m⁻².d⁻¹ Structure, process optimization: work under progress

New active materials

Tests and optmization: BP = 6.3% for PIN structure

Lifetime

Test platforms under various conditions













